

Módulo de Memória "Unbuffered" de 2 Gbytes

MW02GN6625UA8

2 GigaBytes, DDR2, PC2-5300 (667 MHz), CL5 DIMM 240 Pinos

MW02GN8026UA8

2 GigaBytes, DDR2, PC2-6400 (800 MHz), CL6 DIMM 240 Pinos

Descrição:

Os Produtos **MW02GN6625UA8/MW02GN8026UA8** são Módulos de Memória de 2 Gigabytes, organizados como uma memória DRAM DDR2 de 256Mx64 bits. Cada módulo é composto de dezesseis CIs de DRAM DDR2 128Mx8 em encapsulamento FBGA e uma EEPROM serial na função de SPD (Detecção de Presença Serial — *Serial Presence Detect*), montados em um módulo DIMM de 240 pinos, com contatos dourados, segundo o padrão JEDEC.

Características:

- Mecânica DIMM de 240 pinos, *unbuffered*;
- Arquitetura DDR2 (Double Data Rate); duas transferências de dados por ciclo de clock;
- Controle de Terminação no *Die*;
- Utiliza DRAMs DDR2 na organização 128Mx8;
- Entradas de *clock* diferenciais;
- Tamanho de burst programável: 4 ou 8
- Tempo de ciclo de *clock* (MW02GN6625UA8)
 - (t_{CK}) = 3,00 ns (mín.) / 8 ns (máx.) @ CL=5
- Tempo de ciclo de *clock* (MW02GN8026UA8)
 - (t_{CK}) = 2,50 ns (mín.) / 8 ns (máx.) @ CL=6
- EEPROM para Detecção de presença Serial (SPD)
- Strobe de dados bidirecional e diferencial (sinais DQS e /DQS);
- Oito bancos internos aos CIs para operação concorrente;
- Tempo de *Auto Refresh* para estado Ativo (t_{RFC}): 127,5ns (mín)
- Auto-precarga
- Modos de Auto-refresh e Self-refresh
- Endereços de Linha: A₀-A₁₃
- Endereços de Coluna: A₀-A₉
- Endereços de Banco: BA₀~BA₂
- Interface SSTL_18
- VDD = VDDQ = 1,8 V ± 0,1 V

Especificações:

Símbolo	Característica AC	Mín.	Máx.	Unid.	
t_{CK}	Tempo de Ciclo de Clock	MW02GN6625UA8 CL=5	3000	8000	ps
		MW02GN8026UA8 CL=6	2500		
t_{RC}	Tempo de Ciclo de Linha (Operação)	MW02GN6625UA8	57	-	ns
		MW02GN8026UA8	57,5		
t_{RAS}	Tempo de Linha Ativa	45	70000	ns	
t_{RFC}	Tempo de Auto-Refresh para Ativo / Comando de Auto-Refresh	127,5	-	ns	

Valores Típicos:

	Valor	Unid.	Condição
Dissipação de Potência, Operando 1 Banco Ativando Linha, Precarga 1 Banco Inativo, Standby @VDD, VDDQ = 1,8V	MW01GN5324U58	3,024	W Ta=25°C
	MW01GN6625U58	3,125	
Temperatura de Operação ¹	0 ~ 85	°C	
Temperatura de Armazenagem	-55 ~ 100	°C	

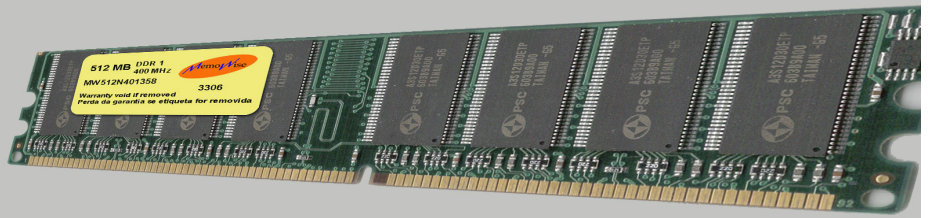
Nota:

1. Refere-se à temperatura no encapsulamento dos CIs de DRAM.

Todos os valores nesta folha de dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Memowise não assume nenhuma responsabilidade pelo uso desta informação, nem pela infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso.

AVISO: NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS DE SUPORTE À VIDA

NÃO SE AUTORIZA O USO DOS PRODUTOS MEMOWISE COMO COMPONENTES CRÍTICOS EM DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE SUPORTE À VIDA SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DA MEMOWISE TECNOLOGIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.



Módulo de Memória "Unbuffered" — MW02GN6625UA8 / MW02GN8026UA8

Dimensões

Todas as dimensões estão em milímetros (polegadas); a tolerância é $\pm 0,127$ (0,005") exceto onde indicado.

